

佐賀大学シンクロトン光応用研究センター 講演会

招待講演

Si基板上への窒化物 半導体薄膜成長の 歪制御新手法

A new approach to the strain engineering of
III-nitrides grown on Si substrates.

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
先進パワーエレクトロニクス研究センター

上級主任研究員 **沈 旭強**

日時・
会場

2017年

6月9日(金)

15:00~16:00

佐賀大学理工学部
8号館308号室

参加費：**無料** (学生の方も歓迎します。)

■お問合せ先

佐賀大学シンクロトン光応用研究センター事務室 TEL: 0952-28-8854

E-mail: slcjimu@ml.cc.saga-u.ac.jp HP: <http://www.slc.saga-u.ac.jp/>

共催：シンクロトンに関する大学間連携会議